

Изобретение относится к области полупроводниковой физики и может быть использовано для получения тонких полупроводниковых слоев, в частности тонких слоев оксидных полупроводников.

Сущность изобретения состоит в том, что способ включает предварительное получение гидролитическим путем водной суспензии полупроводникового оксида и пульверизацию ее на нагретую подложку. Пульверизацию осуществляют в электрической печи, с применением кислорода в качестве газа-распылителя, причем осаждение суспензии осуществляют на подложку, расположенную на вращающемся основании, при одновременном отводе воздуха из печи.

Результат изобретения состоит в получении однородных по толщине тонких слоев с идентичными электрическими и оптическими параметрами по всей поверхности.

П. формулы: 1

Фиг.: 1